



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14112—93

---

## 半导体集成电路 塑料双列封装冲制型引线框架规范

Semiconductor integrated circuits  
Specification for stamped leadframes of plastic DIP

1993-01-21 发布

1993-08-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 半导体集成电路 塑料双列封装冲制型引线框架规范

GB/T 14112—93

Semiconductor integrated circuits  
Specification for stamped leadframes of plastic DIP

### 1 主题内容与适用范围

本规范规定了半导体集成电路塑料双列封装冲制型引线框架(以下简称引线框架)的技术要求及检验规则。

本规范适用于双列(DIP)冲制型引线框架,单列冲制型引线框架亦可参照使用。

### 2 引用标准

GB 4719 半导体集成电路新产品定型鉴定的程序规则

GB 7092 半导体集成电路外形尺寸

GB/T 14113 半导体集成电路封装术语

IEC 410 计数检查抽样方案和程序

### 3 技术要求

#### 3.1 引线框架尺寸

引线框架的尺寸应符合 GB 7092 的有关规定,并符合引线框架设计图纸的要求。

#### 3.2 引线框架形状和位置公差

3.2.1 侧弯小于 0.05mm/150mm(见本规范附录 A1)。

3.2.2 卷曲小于 0.5mm/150mm(见本规范附录 A2)。

3.2.3 横弯小于标称条宽的 0.5%(见本规范附录 A3)。

3.2.4 框架扭曲小于 0.5mm(见本规范附录 A4)。

3.2.5 引线扭曲不超过  $3^{\circ}30'$ ,即在距离内引线端点 0.25mm 处测得扭曲值不大于 0.02mm(见本规范附录 A5)。

3.2.6 在保证精压宽度不小于引线宽度 80%的条件下,精压深度不大于材料厚度的 30%(见本规范附录 A6)。

3.2.7 材料厚度为 0.25mm 时,相邻两精压区端点间的间隔及精压区端点与芯片粘接区间的间隔大于 0.15mm(见本规范附录 A7)。

3.2.8 材料厚度为 0.25mm 时,精压区共面性(见本规范附录 A8)应符合表 1 的规定。

表 1

mm

引线框架条宽	精压区共面性
<25.4	$\pm 0.10$